

一种平面型GaAs场效应晶体管

摘要点击: 1523 全文下载: 829

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)

所在位置: 1980, 1(2): 121-126

中文关键词:

英文关键词:

基金项目:

PACC代码:

EEACC代码:

作者

单位

[邓先旭](#)

中文摘要:

本文提出了一种新的平面型砷化镓肖特基势垒场效应晶体管(GaAs MESFET)结构. 阐述了用氧离子注入制作此种平面型器件的计算和实验结果. 将制得的平面器件与通常的台式器件作了比较. 看出平面型器件在微波特性和制作工艺上具有明显优点.

英文摘要:

您是第642761位访问者

主办单位: 中国电子学会, 中国科学院半导体研究所 单位地址: 北京市海淀区清华东路甲35号

Service Tel: 010-82304277, 82304311 Fax: 010-82305052 邮编: 100083 Email: cjs@semi.ac.cn

本系统由勤云电子有限公司设计, 技术支持电话: 010-81928386, Email: et_yehu@yahoo.com.cn, 网址: <http://www.e-tiller.com>